

IV1Q12160BD- 1200V 160mΩ SiC MOSFET 芯片

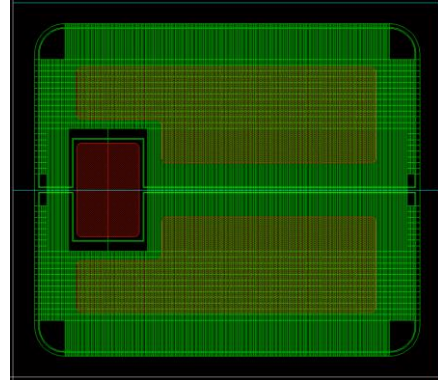
特点

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管

应用

- 光伏逆变器
- UPS 电源
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

芯片外观



产品代码	芯片尺寸
IV1Q12160BD	2.400×2.110mm ²

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	<1%占空比, 脉冲宽度 <200ns	
V _{GSon}	推荐的开通栅源电压	20±0.5	V		
V _{GSoff}	推荐的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	19	A	V _{GS} =20V, T _C =25°C	图 21
		14	A	V _{GS} =20V, T _C =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	48	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	134	W	T _C =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

备注: 假设热阻 R_{θ(j-c)}<1.122°C/W

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{TH}	阈值电压	1.8	2.9	5	V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =1.9mA	图 8, 9
			1.9			V _{GS} =V _{DS} , I _D =1.9mA @ T _c =175°C	
R _{ON}	导通电阻		160	195	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =10A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			285		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =10A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		895		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=1MHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{oss}	输出电容		43		pF		
C _{rss}	反向传输电容		2		pF		
E _{oss}	输出电容存储能量		4.2		μJ		图 17
Q _g	栅极总电荷		43		nC	V _{DS} =800V, I _D =10A, V _{GS} =-5 to 20V	图 18
Q _{gs}	栅源电荷		9		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		19		nC		
R _g	栅极输入电阻		8.5		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	导通能量		204		μJ	V _{DS} =800V, I _D =10A, V _{GS} =-2 to 20V, R _{G(ext)} =3.3Ω, L=450μH	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		34.4		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		15.2		ns		
t _r	上升时间		14.4				
t _{d(off)}	关断延迟时间		11.3				
t _f	下降时间		13.1				

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		4.1		V	I _{SD} =5A, V _{GS} =0V	图 10, 11, 12
			3.7		V	I _{SD} =5A, V _{GS} =0V, T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		33.2		ns	V _{GS} =-2V/+20V,	
Q _{rr}	反向恢复电荷		101.5		nC	I _{SD} =10A, V _R =800V, di/dt=1000A/us,	
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		5.6		A	R _{G(ext)} =13Ω	

注意：所有的数据请参考产品代码为 IV1Q12160T3 封装器件的数据手册。

典型特征曲线

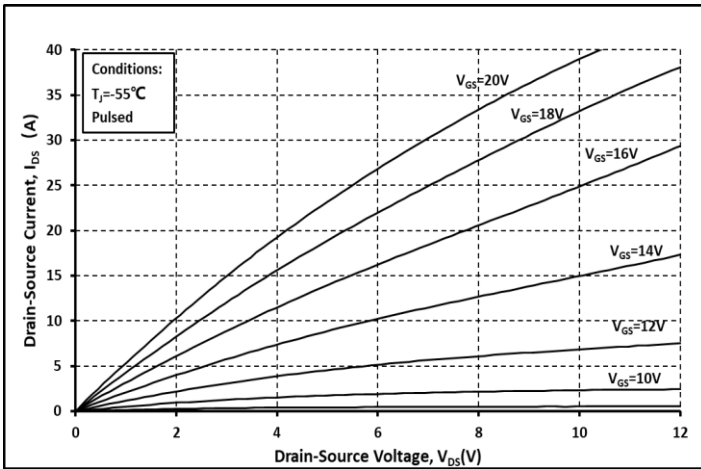


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

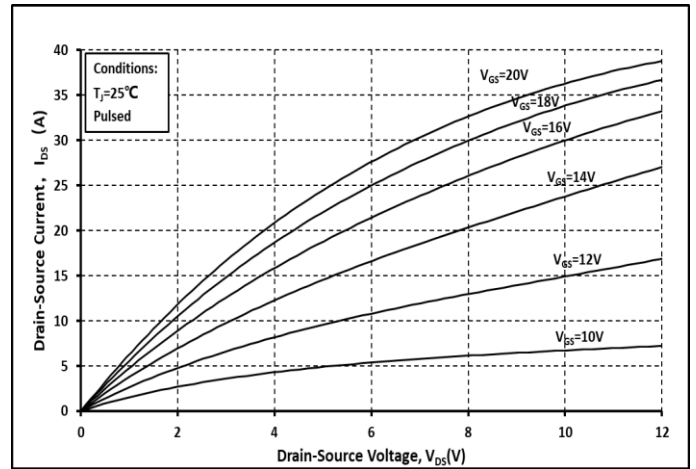


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

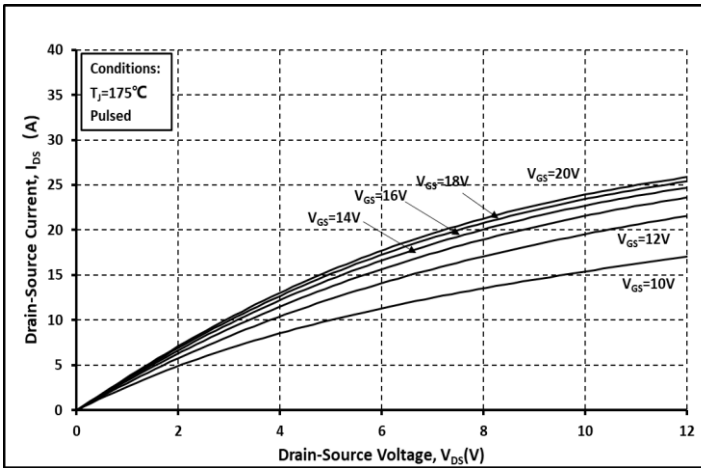


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

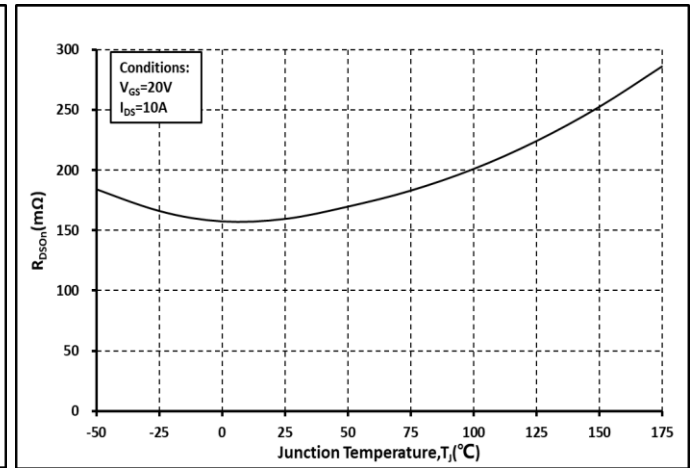


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

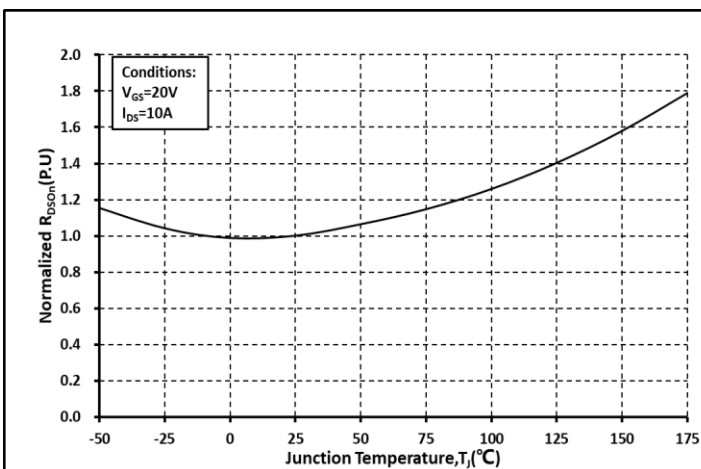


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

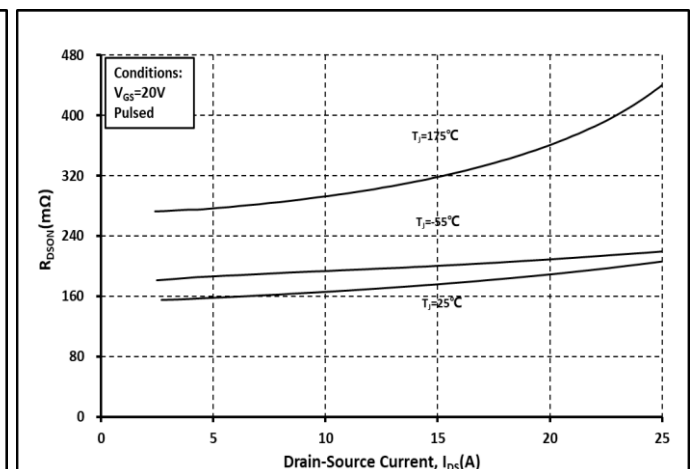


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{ds} 关系曲线

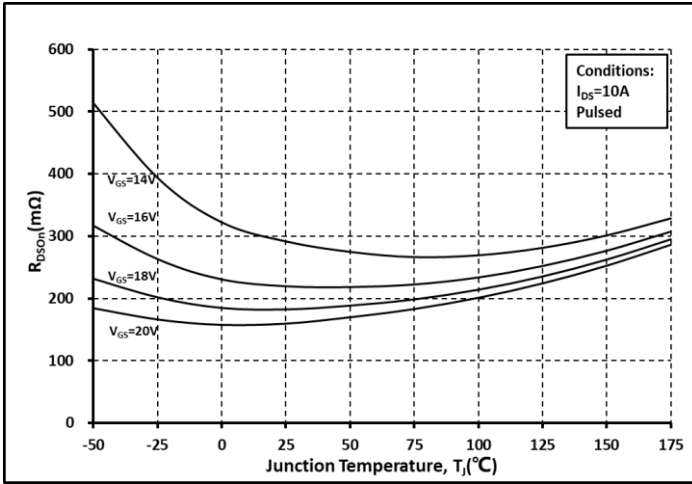


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

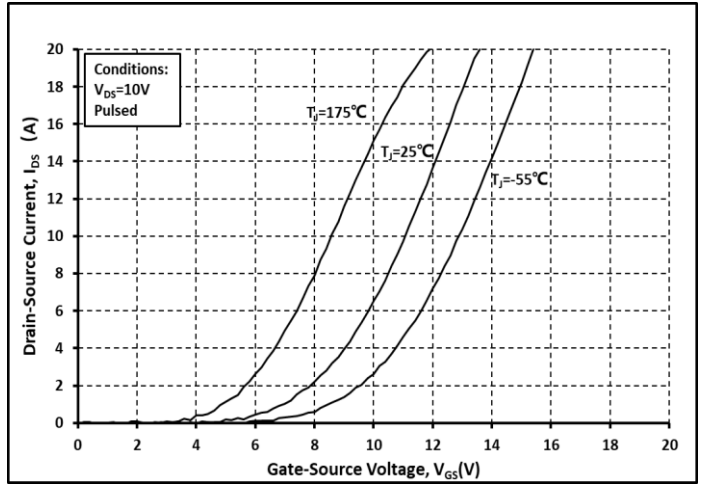


图. 8 各温度下的传输特性曲线

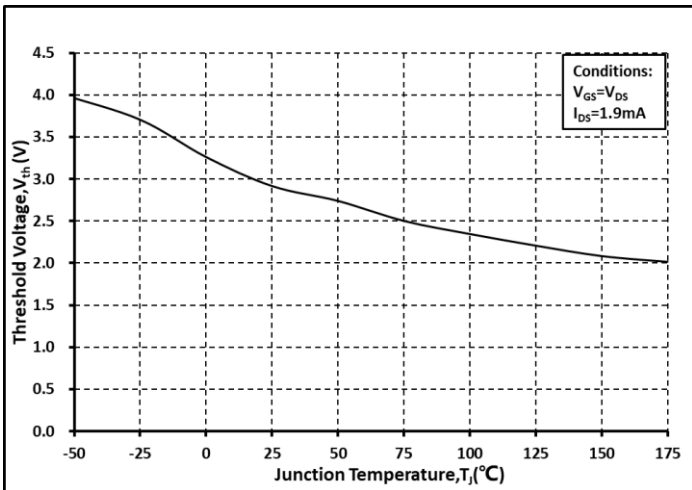


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

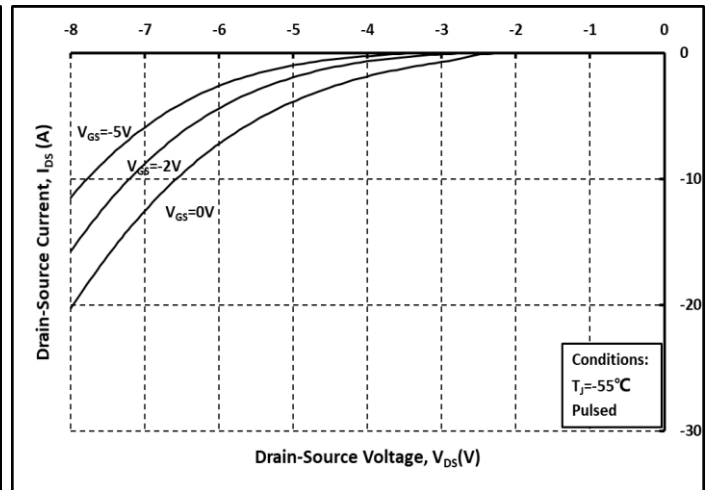


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

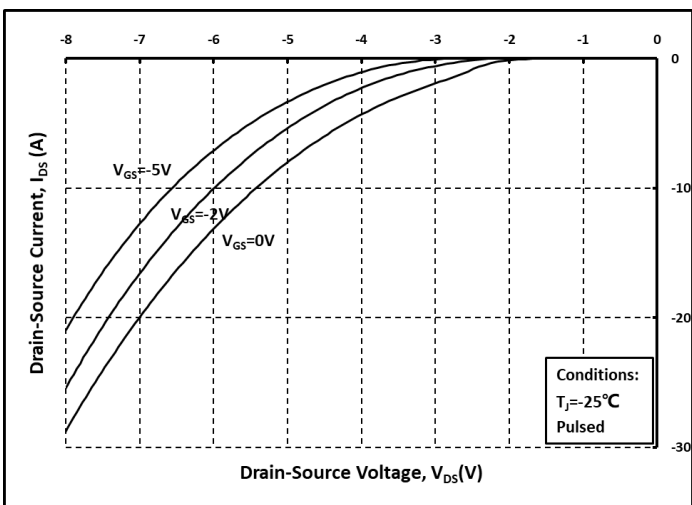


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

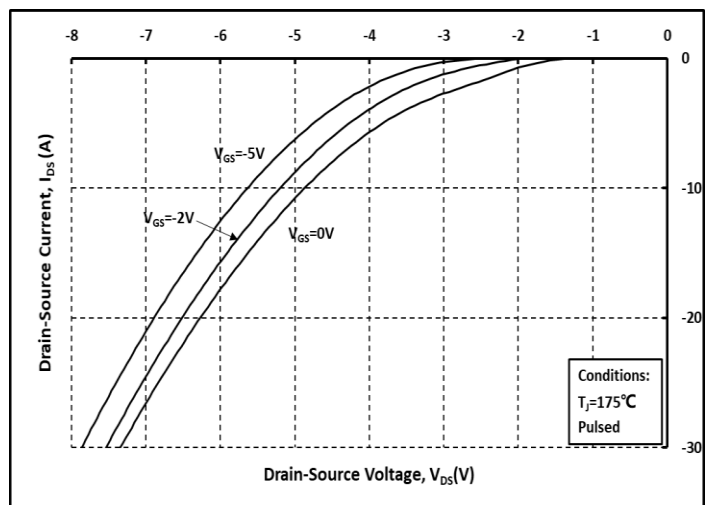


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

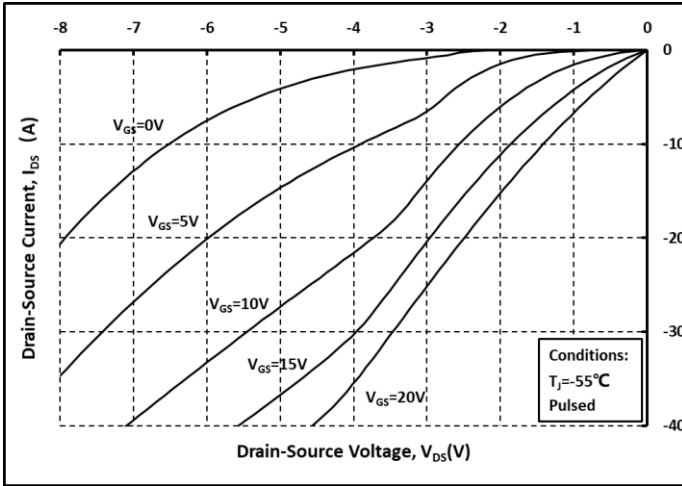


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

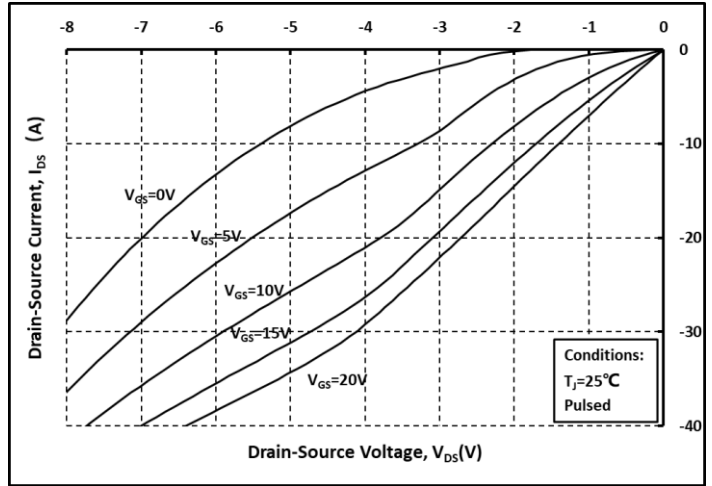


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

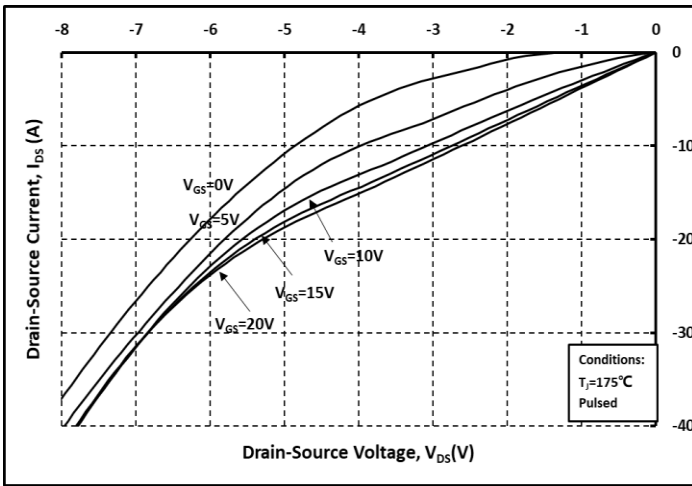


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

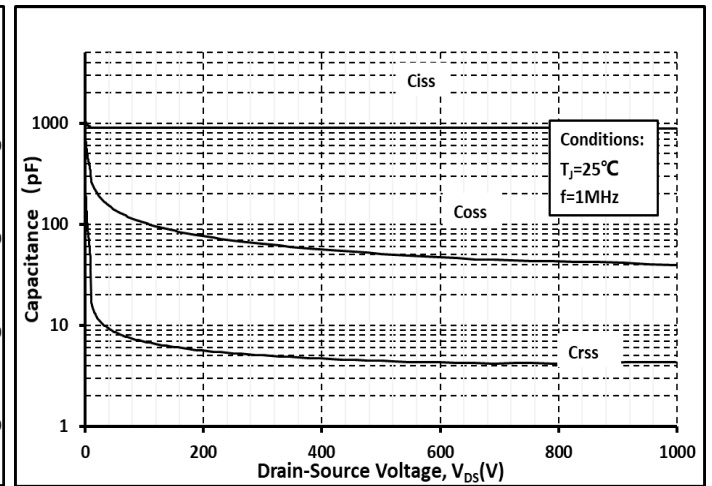


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

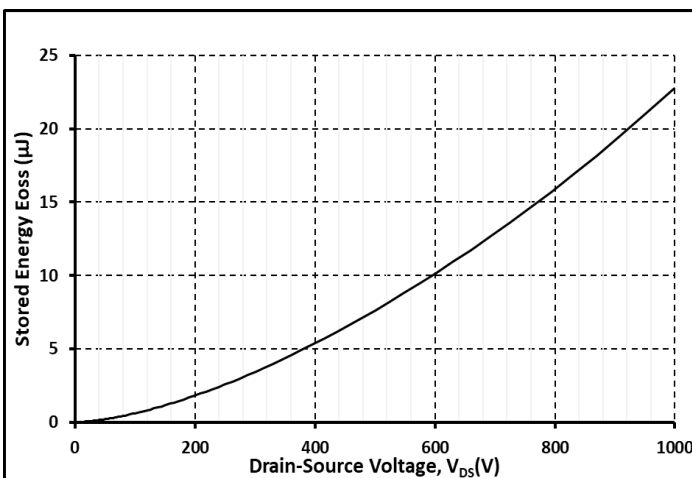


图. 17 输出电容存储能量曲线 c

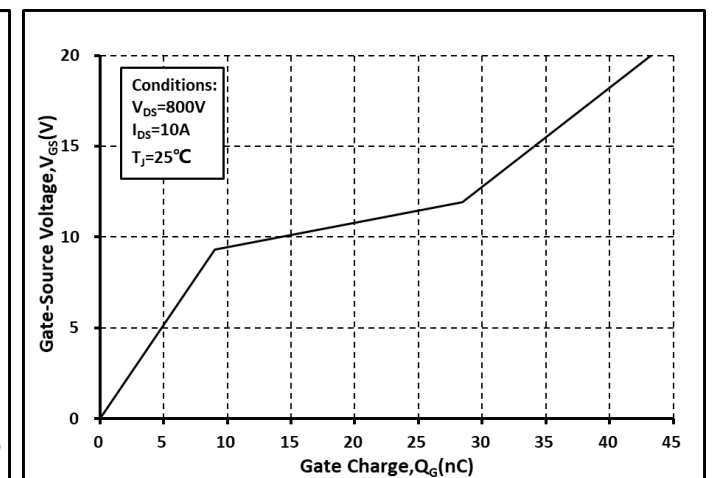


图. 18 栅电荷特征曲线 c

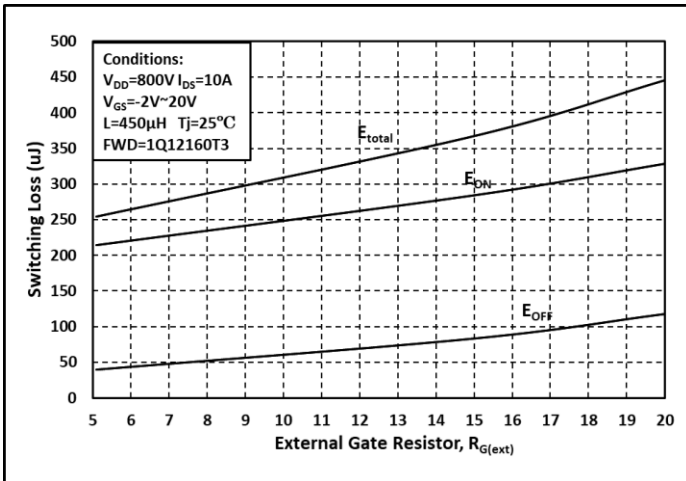


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

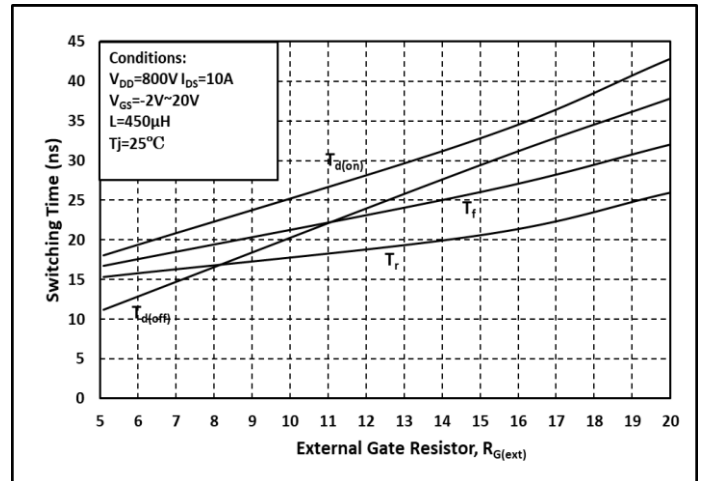


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

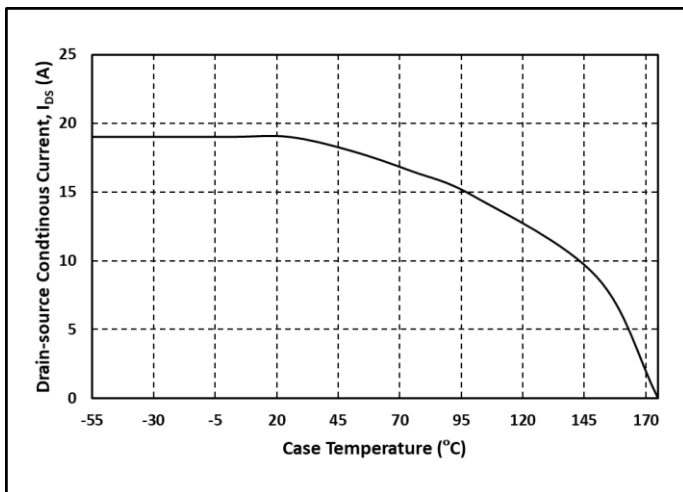


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

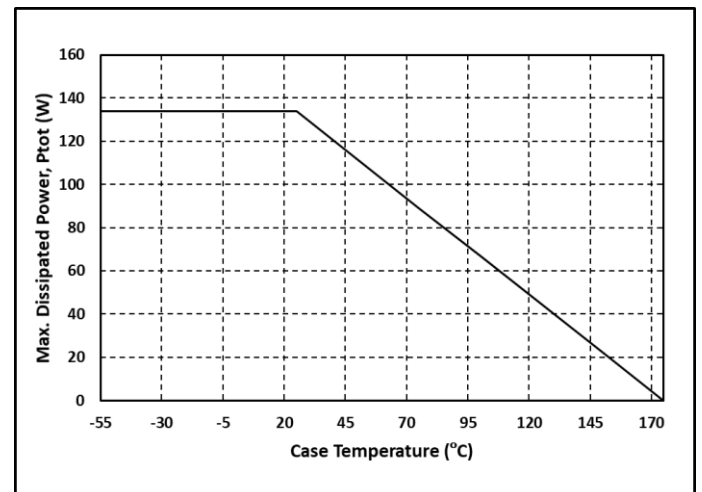


图. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

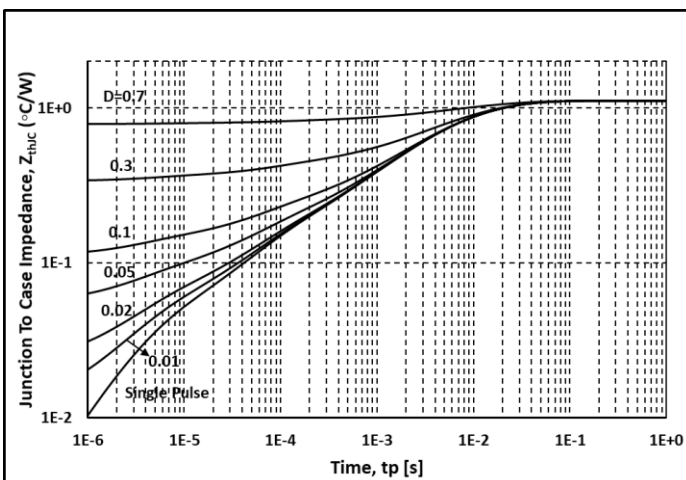


图. 23 热阻曲线

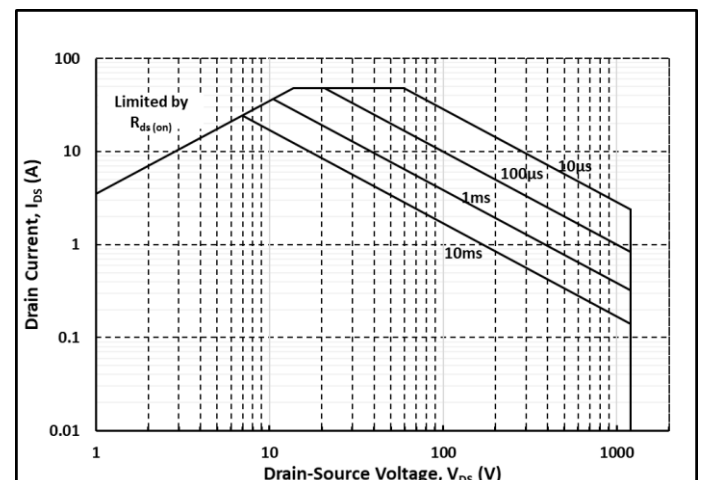
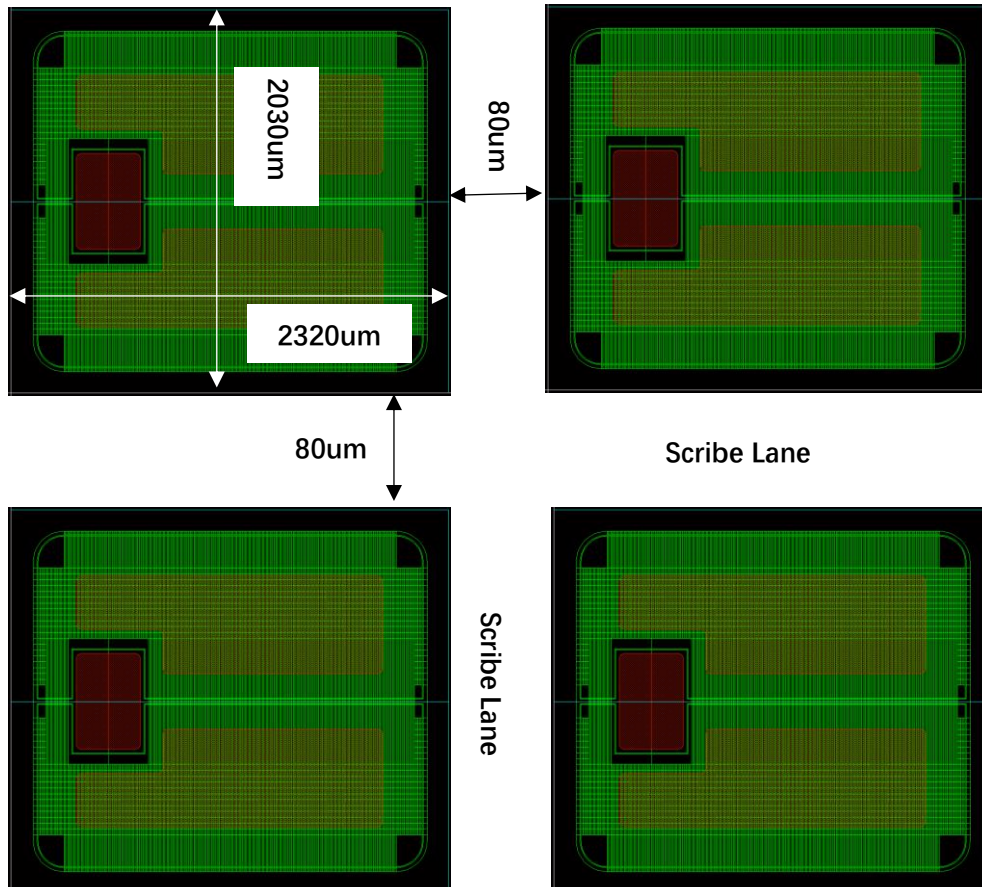


图. 24 安全工作区示意图

机械参数

参数	典型值	单位
芯片尺寸	2.400*2.110	mm ²
漏极焊盘尺寸 (L*W)	1.600*0.520	mm ²
栅极焊盘尺寸 (L*W)	0.340*0.510	mm ²
厚度	365 ₊₃₀	μm
晶圆尺寸	150	mm
顶层漏极金属层 (Al)	4	μm
顶层栅极金属层 (Al)	4	μm
底层漏极金属层 (Ti/Ni/Ag)	0.2/0.2/1	μm
正面保护层 (聚酰亚胺)	5	um

芯片尺寸



说明

如欲了解更多的产品及公司信息，请联系公司相关人员或登录公司网站。

Copyright©2021 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip\(瞻芯电子\)](#)